# **ELECTRO-OPTICAL DEVICE AND MANUFACTURE THEREOF**

Patent Number:

JP4212931

Publication date:

1992-08-04

Inventor(s):

OBARA HIROSHI: others: 03

Applicant(s)::

SEIKO EPSON CORP

Requested Patent:

**▽** JP4212931

Application Number: JP19900328261 19901128

Priority Number(s):

IPC Classification:

G02F1/1335; G02F1/1333; G02F1/137

EC Classification:

Equivalents:

JP3167716B2

#### **Abstract**

PURPOSE:To form a display easily visible so as to widen further a visual angle by providing a metal film as a reflecting layer on a fine irregular surface provided in a liquid crystal layer side of a substrate. CONSTITUTION: A liquid crystal cell 1 is formed by holding a liquid crystal layer 4 between a pair of upper and lower substrates 2, 3. A transparent electrode 5 of ITO or the like is provided in a surface in a side of the liquid crystal layer 4 of the upper side substrate 2, and a thin metal film 6 is provided as a reflecting layer in an internal surface of the other substrate 3. By providing fine irregularity on the surface in the side of the liquid crystal layer 4 of the lower side substrate 3 and the thin metal film 6 in a surface of the irregularity, it is spread to also a surface of the metal film 6. A glass substrate or a synthetic resin substrate of polyethylene terephthalate or the like is used as the substrate 3. Or a substrate, in which an organic film of acrylic system resin or the like is provided in a surface of the glass substrate, is used. Accordingly, a reflecting layer 6, having fine irregularity on a surface in a side of the liquid crystal layer 4, is formed to well perform scattering by this reflecting layer.

Data supplied from the esp@cenet database - 12

### ⑩ 日本国特許庁(JP)

⑩特許出願公開

# ⑫ 公 開 特 許 公 報 (A) 平4-212931

③Int.Cl.5 識別記号 庁内整理番号 ④公開 平成4年(1992)8月4日 G 02 F 1/1335 5 2 0 7724-2K 8806-2K 5 0 0 7724-2K※ 審査請求 未請求 請求項の数 22 (全7頁)

**②発明の名称** 電気光学装置およびその製造方法

②特 顕 平2-328261

②出 願 平2(1990)11月28日

@発 明 者 小 原 浩 志 長野県諏訪市大和3丁目3番5号 セイコーエブソン株式 会社内

⑥発 明 者 飯 島 千代 明 長野県諏訪市大和3丁目3番5号 セイコーエブソン株式

会社内

@発 明 者 西 澤 均 長野県諏訪市大和3丁目3番5号 セイコーエブソレ株式 会社内

⑤出 願 人 セイコーエブソン株式 東京都新宿区西新宿2丁目4番1号

会社

®代理人 弁理士 菅 直人 外1名 最終頁に続く

#### 明 福 事

1. 発明の名称

電気光学装置およびその製造方法

- 2. 特許請求の範囲
- (1)対向する一対の基板間に液晶層を挟持してなる液晶セルの一方の基板の液晶層側の面に、 反射層を有する電気光学装置において、上記反射 層を有する基板の液晶層側に微細な凹凸を有し、 その凹凸の表面に上記反射層としての金属膜を有 することを特徴とする電気光学装置。
- (2) 前記一対の基板のうち少な、とも反射層 を有する側の基板は、ガラス基板または合成樹脂 基板である雑求項(!)記載の電気光学装置。
- (3) 雨記一対の基板のうち少なくとも反射層を有する側の基板は、ガラス基板上に有機膜を有するものであり、そのガラス基板と有機膜のうち少なくとも有機膜の液晶管側の面に前記凹凸を有する線状項()記載の電気光学装置。
- (4) 町記の反射署を有する側の基板は、痕器 層側の面に電極を有するものであり、その基板と

電極のうち少な(とも電極の液晶層側の面に前記の凹凸を有する構求項(1)、(2)または(3)記載の電気光学装置。

- (5) 和記凹凸のピッチは不均一であり、その平均ピッチは80μm以下 凹凸の高さは2μm以下である請求項(1)、(2)または(3)記載の電気光学装置。
- (6) 前記金属膜の製厚は5 μm以下である譜 求項(I)記載の電気光学装置。
- (7) 前記金属限は電橋を兼ねる請求項(1)~(6 のいずれかに記載の電気光学装置。
- (8) 前記液晶層がネマチック液晶またはねしれ配向したネマチック液晶、もし、はコレステリック液晶であることを特徴とする請求項(!)~(!) Cいずれかに記載の電気光学装置。
- (3) 射能液晶層に二色性染料を添加したことを特価とする排水項(8)記載の電気光学装置。
- (10)前記被晶層が、高分子保持体中に機晶が分散されて形成されたことを特徴とする雑水項(3)または(5)記載の電気光学装置。

- (11) 町記液晶層が電界制御により光散乱を起こすことを特徴とする情光項(1)~(1)、(10)のいずれかに記載の電気光学装置。
- (12)対向する一対の基板間に商品層を挟持してなる痕器セルの一方の基板の痕器層側の面に、反射層を形成した電気光学装置を製造するに当たり、上記反射層を形成する基板の痕器層側の面に強縮な凹凸を形成し、必要に応じてその凹凸表面を神嫌処理した後、その凹凸表面に上記反射層としての金属機を形成することを特徴とする電気光学装置の製造方法。
- (13) 南記一対の基板のうち少なくとも反射層を有する例の基板は、ガラス基板または合成樹脂基板であり、そのガラス基板または合成樹脂基板の液晶層側の面に前記の凹凸をホーニング処理により形成することを特徴とする緯状項(12)記数の電気光学装置の製造方法。
- (14) 前記一対の基板のうち少なくとも反射層 を有する例の基板は、ガラス基板上に有機膜を有 するものであり、そのガラス基板の複品層側の面

に有機関を形成した後、その有機関の成品管側の 面に前記の凹凸をホーニング処理により形成する ことを特徴とする請求項(12)記載の電気光学装置 の製造方法。

- (15) 前記一対の基板のうち少なくとも反射響を有する側の基板は、ガラス基板上に有機膜を有するものであり、そのガラス基板の機器管側の面に前記の凹凸をホーニング処理により形式した後、そのガラス基板の液晶層側の面に有機膜を形成することを特徴とする辨果項(12)記載の電気光学装置の製造方法。
- (16) 配記の補條処理としてガラス基板または 合成樹脂基板の基材目体を腐食させるエッチャン トを用いて上記の凹凸表面を軽くエッチンク処理 することを特徴とする請求項(12)記載の電気光学 接置の製造方法。
- ((\*\*)) 前記の補俸処理として前記凹凸の凸部を研磨して凹凸の高さを調整することを特徴とする 請求項(12:記載の電気光学装置の製造方法。
  - (18)前記金属膜は、スパッタもしらは深着等

の真空成膜法により成模することを特徴とする語 水項(12)記載の電気光学装置の製造方法。

- (19) 前記金属模は 成膜された後に、200~450 で加熱処理することを特徴とする請求項(18) 記載の電気光学装置の製造方法。
- (20) 前記の金属膜を形成する側の基板は所定 ハターンの電極を有し、前記の微細な凹凸を形成 した基板上に上記電極を形成した後に前記の金属 腰を形成することを特徴とする諸求項(12)記載の 電気光学装置の製造方柱。
- (21)前記の金属標を形成する側の基板は所定 パターンの電極を有し、平坦な基板上に形成した 上記電機の表面に、前記の微細な凹凸を形成した 後に前記の金属膜を形成することを特徴とする論 非項(12:記載の電気光学装置の製造方法。
- (22) 前記金属際は、メッキ法により形成することを特徴とする論求項(20)または(21)記載の電気光学装置の製造方法。

#### 3. 発明の詳細な説明

#### (産業上の利用分野)

本発明は根鎖差示装置等の電気光学装置およびその製造方法に関する。

### 〔従来の技術〕

進来の我最表示装置、例えば特別平(- )888828号公報に示される反射型の液晶表示装置においては、対向する一世の基板間に液晶層を挟持してなる液晶セルの一方の基板の液晶層例の間に反射層等を設けることによって、明るい表示が得られるようにすることが提案されている。

しかし 上記従来のものは反射層が必ずしも明確ではなく、反射層として基版の液晶層側の面に 金属標準を平滑に形成すると、その反射層が鏡面 となって使用者の顔や背景が映り、表示が非常に 見づらくなる等の不具合がある。

そこで 基板の液晶層側の面に反射層を形成した後に加熱処理して裏面に凹凸をつける方法や、 反射層形成後にホーニングまたはエッチング処理 して光軟乱面とする方法が提案されている。

#### (発明が解決しようとする課題)

ところが、上記のように加熱処理して表面に凹凸をつける場合には、100~600でと高温でロセスでの加熱処理が必要で、基板の耐熱性が要求され基板の材質に割的がある。しかも凹凸が結晶性の側面に因っているため、光散乳効果がうまく出ない等の不具合がある。

また町述のように、反射層をホーニングする場合は、反射層にピンオール等が生じるおそれがあり、電極と併用する場合には断線や抵抗値が変化して西質に及ぼす悪影響は無視できない。また反射層をエッチングする場合は、反射層表面が等方的にエッチングされるため光散乱効果が少ない等の問題がある。

本発明は上記の問題点を解消することのできる 電気光学装置およびその製造方法を提供すること を目的とする。

#### (課題を解決するための手段)

上記の目的を達成するために本発明による電気 光学装置およびその製造方法は以下の構成とした

する構成であり、基板側の凹凸は金属膜表面にも 成及して機器層側の面に微細な凹凸を有する反射 層が形成され、その反射層で光が良好に散乱され て表示が見やすく、しかも視角が広い電気光学装 置を提供することか可能となる。

また本発明による電気光学装置の製造方法は、 反射層を形成する基板の液晶層側の面に微細な凹凸を形成した後、その凹凸表面に上記反射層としての金属類を形成するようにしたので、反射層にピッオール等が生じることなく、光散乱効果の優れた電気光学装置を容易に製造することが可能となる。

#### (実施例)

以下、本発明による電気光学装置およびその製造方法を、根語表示装置を例にして具体的に説明する。

第1回は本発明による電気光学装置としての後 品表示装置の一般を示す縦断面回である。

図において、1は液晶セルであり、上下一対の 基板2・3間に液晶層4を挟持してなる。 5個の ものである.

即ち、本発明による電気光学装置は、対向する 一対の基板間に被品層を挟持してなる液晶セルの 一方の基板の液晶管側の面に、反射管を有する電 気光学装置において、上記反射管を有する基板の 液晶等側に激矩な凹凸を有し、その凹凸の表面に 上記反射管としての金属標を有することを特徴と する。

また本発明による電気光学装置の製造方生は、 対向する一対の基板間に機晶音を挟持してなる機 晶セルの一方の基板の機晶層側の面に一反射層を 形成した電気光学装置を製造するに当たり、上記 反射層を形成する基板の機晶層側の面に微細な四 凸を形成し、必要に応じてその凹凸表面を補値処 理した後、その凹凸表面に上記反射層としての金 葉膜を形成することを特徴とする。

#### 〔作 用〕

上記のように本発明による電気光学装置は、反 計層を有する基板の液晶層例に微細な凹凸を有し、 その凹凸の表面に上記及射層としての金属膜を有

基板での液晶管は側の面には、ITO等の透明電極をか設けられ、他方の基板での内面には、反射 層としての違い金属膜をが設けられている。では スペーサ、8は鴟光板を示す。

そして本実施例は、下側の基板3の液晶管4側の面に微細な凹凸を設け、その表面に上記の薄い 金属機6を設けることによって、金属類6の表面 にも凹凸が成及するようにしたものである。

なお、液晶層の層厚が均一になるように金属膜 6 の表面上に5i0x等の無機製や有機膜を堕布する こともある。また液晶分子が均一に配向するよう にポリイミド、ボンビニルアルコール等の高分子 有機薄膜をデビッグ処理することもある。

和記の基板3としては、例えばカラス基板を用いる。またはポリエチレンデレフタレート(PET)、ポリエーデルサルファン(PES)、ポリカーホネート(PC)等の合成樹脂基板を用いてもより、あるいはガラス基板の表面にアクリル系樹脂、エポキン樹脂、ホケイミド樹脂、ポリィミドサ脂、、ラノール系樹脂等の有機関を有

### 持期平4~212931(4)

するものを用いることもできる。なお基板 3 は必ずしも透明である必要はない。また基板はその両 表面が異方性事電性を有するものでもよい。

上記のように有機限を有するガラス基板を用いる場合には、そのガラス基板に前記の凹凸を形成してもよい。特にガラス基板に凹凸を形成したのち有機関を形成する場合、その有機関の厚さは、好ましくは24m以下、より好ましくは0.59m以下にするのが望ましい。

また反射層を構成する金属膜の材質は、アルミニウムその他任意であり、特に制限はない。又その金属膜の膜厚は、好ましくは1 μ m 以下、より好ましくは3 0 0 人以下にするのが望ましい。

上記の金属膜は要求用電極に美用することができる。また、前記の金属膜を有する側の基板として液晶層側に「T ) 等の透明電極もしくは不透明の電極を有するものを用いることもできる。その場合は上記基板と電極のうち少な」とも電極の推晶層側の面に前記の凹凸を設ける。

即ち、本発明による製造方法は、対向する一対の基板間に液晶層を挟持してなる液晶セルの一方の基板の液晶層側の面に反射層を有する液晶表示装置等を製造するに当たり、上記反射層を形成する基板の液晶層側の面に激調な凹凸を形成し、必要に応してその凹凸表面を補俸処理した後、その凹凸表面に上記反射層としての金属膜を形成するものである。

上記の基板に凹凸を形成する手段は任意であるが、例えばホーニッグ処理により形成するとよい。この場合、基板はガラス基板上に前記のような有機関を有するものでもよい。そのガラス基板上に有機関を有するものにあっては、ガラス基板に有機関を形成したのち有機関をホーニング処理して凹凸を形成したのち有機関を形成してもよい。

その有機膜の材質はアクリル樹脂その他適宜で あれ、まな膜深については特に制約条件はない。 上記のように基板の機器事例の面に凹凸を設け、その表面に反射層として頂い金属機を設けることにより、基板側の凹凸が金属類表面に被及し、その凹凸面が光粒乱面となって観察面側(図で上側)から上射した光を良好に散乱反射させることができるものである。

なおその場合、第3図似に示すように観察者側に反射光が多くなるように制御するのが望ましく、例えば凹凸のピッチを均一に形成すると、反射光に指向性を生し、全方向に対して均一に効果が生しないため、凹凸のピッチは第2図のように不均一にランチムに形成するのが望ましい。又その場合の凹凸の平均ピッチョは、80ヵm以下、より好ましくは10ヵm以下とするのが望まして3.6ヵm以下。より好ましくは0.3ヵm以下とするのが望ましい。

次に、上記のような機器表示装置等の電気光学 装置の製造方法を具体的に説明する。

有機膜をガラス基板上に形成する手段は、使布その他適宜であり、また有機膜の形成位置は 信号入力用端子解は避け上記の凹凸を形成すべき位置にのみ選択的に形成するのが、信頼性の上からも有効で望ましい。例えば感光性アクリル巣脂をスピッコート法でミュー原で全面コートした後、フォトマスで下翼のパターンのみに紫外線を照射して光重合きせ、残りを現像処理して有機膜を形成することができる。

利配の基板にホーニング処理により凹凸を形成する際の研磨粒子は、ガラス基板にあっては酸化セリウム等を用いるとよう、また前記の合成樹脂基板もしいは有機膜にあってはポリピニルアルコールやポークレタン系樹脂等の粒子を用いるとよい。又それ等の粒径は、10gm以下、より好ましくは5gm以下のものを用いるのが望ましい。

きらに ホーニング処理する方向は基板に対して鉛道(垂直)方向から行うに、形成される凹凸の高さが大き、なり製御した 3なるため、鉛道方向に対して所定の角度傾斜させて行うことが、

均一で機い凹凸を形成する上で望ましく。上記の 傾斜角度に好ましては鉛直方向に対して4.5°以 上傾斜させるとよい。

なお、ホーニンで処理以外の方法として、ガニス基板をご・酸でエッチングして凹凸を形成する方法が有効である。また前記の補格処理としてお、例えばフ・酸を用いて基板上に形成された凹凸を面を軽(エ・チング処理する、あるいは上記凹凸の凸部を研磨して凹凸の高さを調整する方法をとり得る。

上記のつい顔を用いて基板上に形成された凹凸 表面を軽・エッチング処理する場合には、ホーニング処理したガラス基板を、ホーニングした面側 にフッ酸もしくはフッ酸とフッ化アンモニウムと の混合板(混合比4:1~1:4、程度により調 等)を用いて20~40℃で浸慮し、エッチング することにより凹凸の高さや形状を調整する。

また上記のように凸部を研磨する場合は、研磨する基板の材質に応じて研磨材を通宜選択するもので、例えば前述したホーニング処理に用いる研

熱性の高いものであれば、上記の加熱処理が可能であり。例えばポリイミド樹脂の場合には2.2.0 ~ 2.4.0 でで加熱処理できる。

上記のようにして基板上に形成した金属機は、バターニングして要示用電極とする。この場合、電極形成はバターニングの前でも後でもよいが加熱処理して結晶性のかわった裏面はエッチングはにルートが変わるため望ましくはバターニング後に加熱するとよい。また上記の加熱処理は空気中でもよいが一金属によっては、例えばプロムのように酸化して反射率の低下するものがあるため、望ましくは不活性ガス雰囲気中で処理するとよい。

なお 前記の基拠と金属膜との間には、(10年の透明または不透明の電極を設けることも可能であり、この場合、前記のよっにして凹凸を形成した極板上に1TC等の所変のパターンの電極を形成した後、金属膜を形成する。あるいは平らな番板上に電極を形成し、その電極表面に前記と同様の要罪で凹凸を形成した後、金属膜を形成することもできる。又この場合、上記の金属膜はエッ

磨粒子と同じものを用いる。

次ので上記のようにして阿凸を形成した基板上に反射層としての金属膜を形成するもので、例えばスパッタもしくは原著等の真空成製法により形成する。この場合、成際レートは早い方が鞭に四凸ができやすく、例えば80~250人/ain 程度が望ましい。また成項程度は10~~100と程度が望ましい。

具体的には、例えばスパッタ法の場合は、膜形成レートが200人/min 程度、成膜温度が1800程度で程度をCCO人程度形成すればよく、減者法の場合は現形成レートが100人/min程度、改膜温度が200で程度で模定5000人程度形成すればよい。

上記のようにして形成した金属模は、必要に定 して加熱処理して凹凸をコントロールすると、強 観なピッチの凹凸とすることができる。例えばカ ラス春板を用いる場合は、200~450℃で空 気中で加熱処理すればよい。また合成樹脂基板も してはカラス基板上に有機鞭を有するものでも解

ケル等をメッキして开放することもできる。

- 具体的には、例えば以下の要額で形成する。す なわち、質種が形成された基板を20円CKOB 溶液の中に常温で1.0分間浸漉して肥脂を行い、 5 号のHC2溶液に常温で5分間浸漉して中和さ せる。次いで、その基板表面上に無電解・ッキを 開始してパラジウムを付着させる。これは例えば 15%のHC2溶液中に増密剤(日立化成工業株 式会社聖 商品名HS--10(B)を下別混合し 常温で10分間浸漬させることにより行っ。次い で、ニッケルメッキ歳の中にガラス基板を浸漉さ せ透明電極上に平均膜厚で300人程度のニッケ ルメミキを行い、その表面をボーニング処理して 凹凸を形成すればよい。この場合の研磨剤の粒子 径は作えば20日m程度のものを用い、凹凸の平 | 拘足ッチは2gm に高さは3.4gm 程度に形成 T3.

### 特開平4~212931(6)

ッキ、電解メッキの選択が可能である。

上記の要領で製造することにより、基板上の金 護膜表面に微幅な凹凸を形成することができるも ので、実際に金属膜裏面に平均ピッチ1~2μm、 深さ約6.1~0.2μmの凹凸を良好に形成するこ とができた。又その基板を用い、それと対向する 基板間にノール部を介して液晶を挟持させ、その 対向する基板の外側に偏光板を設置して180° ~2~0~ねこれ配向したネマチック液晶層を用 いた液晶表示装置を作成したところ、反射層が軟 乱状態となっているため背景等が映ることがなく、 従来の反射板を基板の外側に付加するものと比較 して明るく影がでることなく、しかも広視角の反 射型液晶表示装置を得ることができた。また電極 が金属でできるため低抵抗電極となり、入力電圧 波形のなまりか殆どなく、クロストーク等の画像 を不均一にする不良が大幅に低減された。

その結果、例えばいわゆるノート型パソコン等 に盛んに採用されている反射型液晶表示装置にお いて、表示を見やすく、しかも薄型・軽量で低消 費電力の装置が得られるものである。

なお本発明は光学的な補償体を備えたいわゆる 白葉表示タイプやカラータイプの液晶表示装置に も適用可能である。また偏光板を多くにも上校し か必要としない工色性染料を用いたデストポスト タイプ、光散乱を利用したDSMや箱分子保持体 中に液晶を分散したPDLC等のタイプに適用可 能である。さらに液晶表示装置に限らず、各種の 電気光学装置にも適用できる。

#### 〔発明の効果〕

以上説明したよっに本発明による電気光学装置は、対向する一対の基板間に被晶層を挟持してなる機器や中の一方の基板の機器層側の面に、反射層を有するものにおいて、上記反射層を有する基板の機器層側に微細な凹凸を有し、その凹凸の表面に上記反射層としての金属膜を有するようにしたから、基板側の凹凸は金属膜表面にも接及して被晶層側の面に微細な凹凸を有する反射層が形成され、その反射層で光が良好に散乱されて表子が見やすく、しかも視角が広い電気光学装置を導る

#### ことができる。

また本発明による電気光学装置の製造方法は、 反射層を形成する基板の液器層側の面に激細な凹凸を形成した後、その凹凸表面に上紀反射層としての金属膜を形成するようにしたから、前紀従来のように反射層にピンオール等が生じることなく、 光軌乱効果の優れた電気光学装置を容易に製造できるものである。

#### 4. 図面の簡単な説明

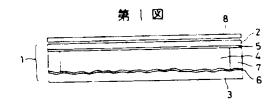
第1図は本発明による電気光学装置の一度緩倒を示す新面図、第2図は基板の斜視図、第3図(a)(b)は反射光分布の説明図である。

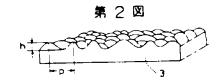
1 は複器セル・2・3 は基板、 4 は液晶層、 5 は電極、 5 は反射層(金属膜)、 7 はスペーサ、 8 は備光板。

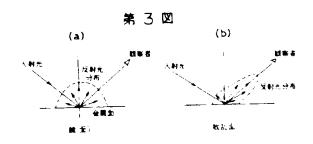
 特許出願人
 セイコーエブソン株式会社

 代理人
 年理士
 音
 直
 人

 同
 高
 46
 塩
 二







## 特開平4-212931(7)

### (自発) 手統補正書



平成 4年 2月10日

特許庁長官 深 沢 亘 取

1. 事件の表示

平成 2年 特 許 顧 第328261号

2. 発明の名称

電気光学装置およびその製造方法

3. 補正をする者

事件との関係 特許出願人 名称 (236)セイコーエブソン株式会社

4、代 理 人

住所 東京都渋谷区代々木2丁目11番12号

木村ビル 6階

電話 03 (3378) 1711

氏名 (7558) 弁理士 菅 直 人

(他1名)

明細書「発明の詳細な説明」の欄 5. 補正の対象

6. 補正の内容

- (1)明細書第11頁3行「表面が異方性導管性 を有するものでもよい。」とあるのを、「麦面間 に導電性をもち表面内では地縁性をもつ異方性導 電性のものでもよい。」に補正する。

(2)同 同頁12行「ニウムその他」とあるの を、「ニウム、銀その他」に補正する。

(3)同 同頁14行 300 A以下, とあるの を、「3000天以下」に補正する。

(4)同 第18頁13行~17行 ルメッキを 行い、その妻面を……に形成する。」とあるの を、「ルメッキを行う。」に補正する。

以上

第1頁の続き

®Int. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

G 02 F 1/137

101

8806-2K

**饲発明者 今井** 秀 一 長野県諏訪市大和3丁目3番5号 セイコーエブソン株式 会社内